

БИБЛИОГРАФИЯ

621.315.592(049.3)

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Landolt-Börnstein. Numerical Data and Functional Relationships in Sciences and Technology. New Series/Editors in Chief K.-H. Hellwege, O. Madelung. — Group III: Crystal and Solid State Physics. V. 17. Semiconductors/ Editors O. Madelung, M. Schulz, H. Weiss. Subvolume i. Special Systems and Topics. Comprehensive Index for III/17 a...i/D. Bimberg, I. Eisele, W. Fuchs, H. Kahlert, N. Karl. Edited by O. Madelung, M. Schulz, H. Weiss. — Berlin; Heidelberg New York; Tokyo: Springer-Verlag, 1985. — 385 p.

Недавно вышел заключительный подтом 17i справочной серии «Ландольт-Бёрнштейн» по полупроводникам. Таким образом, завершено уникальное предприятие, позволившее собрать в единой серии огромный накопившийся к началу 80-х годов справочный материал по физическим свойствам, структурным и технологическим характеристикам практически всех известных к этому моменту полупроводников.

Нельзя, конечно, утверждать, что все данные, собранные в этом справочнике, обладают одинаковой степенью достоверности. Подобное требование неразумно по отношению к изданию, цель которого — дать максимально современную и, по мере возможности, полную информацию о состоянии дел в такой бурно развивающейся области науки, как экспериментальное исследование физических характеристик полупроводниковых материалов. Эта цель изданием «Энциклопедии полупроводников» достигнута.

В современной быстро меняющейся ситуации в технологии специалистам необходимо иметь достаточно простой доступ к информации о всем спектре физических свойств разнообразных полупроводников, чтобы оптимальным образом выбрать материал для реализации своих целей. До выхода аннотируемого издания подобная задача была трудноразрешимой. Теперь она в значительной степени разрешена, поскольку в справочнике содержатся не только подробные таблицы физических характеристик полупроводниковых материалов, но и обширная, весьма представительная библиография оригинальных работ, что позволяет произвести углубленный поиск необходимой информации.

В заключительном подтоме 17i «Специальные системы и предметный указатель» помещены справочные материалы по следующим разделам: 1) аморфные полупроводники, 2) органические полупроводники, 3) слои пространственного заряда на поверхностях и границах раздела, 4) горячие электроны, 5) электрон-дырочная жидкость.

В конце подтома 17i приведен полный предметный указатель по всем предыдущим выпускам тома 17 «Полупроводники».

Здесь для удобства читателей УФН представляется необходимым привести краткое содержание всех предыдущих подтомов тома 17:

<i>Физические параметры полупроводников</i>		Подтом	Раздел
Элементы IV группы и IV—IV соединения	17a	1	
III—V-соединения	17a	2	
II—VI-соединения	17b	3	
I—VI I-соединения	17b	4	
Полуманнитные соединения	17b	5	
Элементы с нететраэдрическими связями	17e	8	
Элементы III группы	17e	8.1	
Элементы V группы	17e	8.2	
Элементы VI группы	17e	8.3	
Бинарные соединения с нететраэдрическими связями	17e	9	
IA — IB-соединения	17e	9.1	
I _x V _y -соединения	17e	9.2	
I _x VI _y -соединения	17e	9.3	
II _x IV _y -соединения	17e	9.4	
II _x V _y -соединения	17e	9.5	
II _x VII _y -соединения	17e	9.6	
III _x IV _y -соединения	17f	9.7	
III _x VII _y -соединения	17f	9.8	
IV _x V _y -соединения	17f	9.9	
IV _x VI _y -соединения	17f	9.10	
IV _x VII _y -соединения	17f	9.11	
V _x VI _y -соединения	17f	9.12	
V _x VII _y -соединения	17f	9.13	
Соединения бора	17g	9.14	
Бинарные соединения переходных металлов	17g	9.15	
Бинарные соединения с редкими землями	17g	9.16	
Тройные соединения	17h	10	
Тройные и квазибинарные соединения с тетраэдрическими связями	17h	10.1	
Тройные соединения переходных металлов	17h	10.2	
Тройные соединения с редкими землями	17h	10.3	
Другие тройные соединения	17h	10.4	
<i>Технология полупроводников</i>		Подтом	Раздел
Полупроводники с тетраэдрическими связями	17c	6	
Si и Ge	17c	6.1	
SiC	17c	6.2	
III—V-соединения	17d	6.3	
II—VI-соединения (широкошелевые)	17d	6.4	
II—VI-соединения (узкошелевые)	17d	6.5	
Полупроводники с нететраэдрическими связями	17d	7	
IV—VI-соединения	17d	7.1	
HgI ₂	17d	7.2	
Se	17d	7.3	

Содержание последнего подтома 17i уже описано выше.